Belle II実験用粒子識別装置 ARICHプロトタイプ検出器の ビームテストデータの解析

首都大学東京 修士1年 柿本詩織

目次

実験概要

- •Belle II実験にいて
- ARICH検出器、HAPDについて

研究内容 ・ビームテストデータの情報

- •解析方法
- •解析結果



7 GeVの電子ビームと4 GeVの陽電子ビームを 用いた衝突型加速器実験。 大量のB中間子対を生成し、その崩壊過程を 精密に調べることで標準模型を超える新物理 を探索。 Belle II 検出器



中央飛跡検出器 CDC

崩壞点検出器 PXD + SVD

粒子識別·飛行時間測定

TOP

長寿命粒子識別 KLM

ARICH検出器



性能目標: P=4 GeV/cの粒子に対して4σ

HAPD(Hybrid Avalanche Photo Detector)



特徴

・1光子検出が可能
 ・1.5Tの高磁場中で動作可能
 ・144chのピクセル検出器
 ・ARICHでは420台使用



動作原理

- ・光電面とAPD間の電場で加速され
 APDに入射
- ・光電子はエネルギーを落として停止し 1500~2000の電子-正孔子対を生成
- ・APD内部のアバランシェ増幅により 40倍のゲインが得られ、最終的に 数万の増幅度になる

ARICHプロトタイプのビームテスト

ARICH最終仕様の決定のためのビームテスト 日時:2013年5月20日~27日に実施 場所:ドイツ DESY

ビーム:電子5 GeV $\beta = \frac{v}{c} = 0.99999 \simeq 1$



6台のHAPDと2層のエアロゲルを使用



ARICHに垂直に入射する粒子に対する性能

運動量3.5 GeVのπ粒子に対して π粒子の識別効率:97% π粒子をK粒子と誤識別する確率:4.9%

約21万イベントの累積リングイメージ





岩田修一博士論文(首都大2015年度) に詳細がまとめられている。

2017/05/20

高エネルギー物理春の学校

研究内容

ARICHに垂直に入射する粒子に対する性能は よく調べられているが、ARICHに対して角度をもって 入射する粒子に対する性能は調べられていない

研究内容

ARICHに垂直に入射する粒子に対する性能は よく調べられているが、ARICHに対して角度をもって 入射する粒子に対する性能は調べられていない ↓ ビームテストデータの中で検出器をビームに対して 傾けたデータを解析する。

研究内容

ARICHに垂直に入射する粒子に対する性能は よく調べられているが、ARICHに対して角度をもって 入射する粒子に対する性能は調べられていない ↓ ビームテストデータの中で検出器をビームに対して 傾けたデータを解析する。



電子ビームの入射角30°の積算リングイメージ



予測されるリングの計算



・電子の飛跡を中心軸として放射角 θ_c の光子の方向ベクトルを計算

予測されるリングの計算



・電子の飛跡を中心軸として放射角 θ_c の光子の方向ベクトルを計算 ・エアロゲル表面とHAPD表面(ガラス)での屈折を考慮してHAPD上での位置を計算

予測されるリングの計算



・電子の飛跡を中心軸として放射角 θ_c の光子の方向ベクトルを計算

π/K識別能力の見積もり方法

運動量4GeV/Cの粒子を仮定した場合 n = 1.0592 :エアロゲル輻射体の屈折率 •π中間子 <u>質量:0.14 *GeV*/c²</u> $\beta_{\pi} = 0.999 \simeq 1$ $\cos\theta_{\pi} = 0.944$ •K中間子 質量:0.5 GeV/c² $\beta_{K} = 0.992$ $\cos\theta_{K} = 0.952$ 今回ビームテストで用いた5GeVの電子は $\beta_{\rho} \simeq 1 \simeq \beta_{\pi}$ →電子をπ中間子として模擬。 K中間子で予測されるリング(β=0.992) ヒット位置 \Leftrightarrow π中間子で予測されるリング(β=1) 比較

HAPDのヒット点と予測されるリングの距離



リングを5つの領域にわけて解析

高エネルギー物理春の学校

π/K**の粒子識別能力**

$$S = \frac{r_{\pi} - r_K}{\sigma_r} \sqrt{N_{pe}}$$

 $r_{\pi} - r_{K}$ [mm]: π 中間子とK中間子のチェレンコフリングの半径差







2017/05/20

高エネルギー物理春の学校

検出光子数の見積もり

1ベントあたりのヒット数分布





先ほどのポアソン分布より求めた1~3トラックイベントの割合 は以下のようになっている。

1トラックイベント	82.52%
2トラックイベント	12.12%
3トラックイベント	5.36%

データのevent数は213407本。これより全トラック数は

(0.8252+0.1212×2+0.0536×3)×213407=261421本

Gaussのメインピークの面積をAとすると(1トラック当たりの) 検出光子数は

$$n_{pe} = \frac{A}{261421}$$
と見積もられる。



1トラック当たりの検出光子数Npe

領域	測定値	参考値		120	
1	0.433			100	
2	1.022	1.071		800	
3	0.487	(亜直入射時のビームテス	(垂直入射時 のビームテス		600
4	0.470	トの測定値)		400	
5	1.077		-100	200	
	_			200	

①~⑤の平均:0.698

・測定値のばらつきはHAPDの配置に起因
 ・測定値は垂直入射時に比べ少ない
 →原因については今後調査

①~⑤の領域:
 放射角θ_cに対して方位角φ180度を
 5等分(1つの領域36[°])

-150 -100 -50 0 50 100 150

識別能力の評価

領域	識別能力	備考	
1	1.03σ		
2	1.48σ	27 <u> </u>	3
3	0.97σ	$S = \frac{r_{\pi} - r_k}{\sigma} \sqrt{N_{pe}}$	
4	1.02σ	して してい してい してい してい してい してい してい してい してい し	5
(5)	1.63σ		
1~5	2.78σ	$\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2}$	
全領域	3.97σ	上の√2倍	→全体生成光子数は2倍

HAPDが全領域をカバーしていると仮定すると 識別能力は<u>3.97</u>を見積もられた。

まとめ

・プロトタイプARICH検出器において入射角30°の粒子に対する 識別能力の見積りを行った。

粒子識別能力を入射角30[°]の4GeV/cの粒子に対して3.97σ と見積もった。

・4GeV/cの粒子に対して約4σの識別能力を持つことを確認した。

<u>Belle II ARICH検出器の要求性能</u>

Back up



b→sγ、b→dγ過程

Flavor Changing Neutral Current過程 ⇒世代は変わるが電荷は変わらない過程 標準模型ではループを介して発生



b→s γ 過程を含む崩壊例 b→d γ 過程を含む崩壊例 B⁰→<u> ρ^{0} γ B⁰→<u> K^{*0} γ L→ $\pi^{+}\pi^{-}$ L→ K+ π^{-} </u></u>

粒子識別能力の向上により、終状態にK[±]・π[±]を多く含む B⁰の崩壊過程を精密に測定することが可能となる

参考:米永匡伸修士論文(2016年度)

アップグレードの効果 例: $B^0 \rightarrow \rho^0 \gamma$ (シミュレーション) Signal mode: $\rho^0 \rightarrow \pi^+\pi^-$ 荷電Κ、π粒子の識別が重要 Background mode: $K^{*0} \rightarrow K^{+}\pi^{-}$



TOP (Time-of-Propagation)

輻射体である石英ガラスのクォーツバーを荷電粒子が通過した際に 発生するCherenkov光を輻射体端部に接続された光検出器で観測し 粒子識別を行う。

荷電粒子の質量の違いによるリング半径差と、Cherenkov放射角が 異なることによるクォーツバー内で全反射を繰り返した際の経路差 の両方を利用することで高い粒子識別を達成することが可能。



CDC(Central Drift Chember)

中央飛跡検出器

検出器内部に充填された混合ガス中を 荷電粒子が通過する際に電離する電子 を検出し粒子の飛跡を再構成する。

読みだされた電荷量から ガス中で失ったエネルギーを 測定することで粒子識別も可能



APD增幅原理

逆Bias電圧の印加によって空乏層が形成されたAPDに 光が入射すると電子-正孔対が生成される。これらそれぞれが 逆Bias電圧によって電極へとドリフトする。この時に空乏層内の 格子原子や不純物と衝突することによって査収的には 入射光電子数に比例した電圧パルスとして 光電子 Avalanche増幅領域 (空乏層)



デュアルレイヤー方式

検出光子数を維持したまま角度分解能を向上できる。



ビームテストデータ(垂直入射)

Run#	125			143	
ビーム	電子 5 GeV/c (磁場なし)				
ビーム入射角	0 deg				
エアロゲル	上流: 1.0467 (REM5-5) 下流: 1.0592 (BTR13-5)			無し	
HAPD	# 5: SHP078 QE: 26.8% 2011以前の旧来品	#3: KA04 QE: 28.9% 2011白側管 (旧来品と同	1 。 雪品 司等)	#1: SHP118 QE: 27.4% 2011以前の旧来品	
(ビーム上流から見た配置)	#6: KA025 QE: 22.3% 2011以前の旧来品	#4: KA05 QE: 31.1% 第1次放射終 (9x10 ¹¹ n,	8 。 泉テスト品 1000Gy)	#2: SHP077 QE: 25.2% 2011以前の旧来品	リングイメージ ^{All}







ビームテストデータ(角度付き)

Run#	145	146	147	148	149	150	151
ビーム	電子 5 GeV/c (磁場なし)						
ビーム 入射角	30 deg						
エアロ ゲル	Run125と同じ						
HAPD	Run125と同じ						
位置	初期位置 x _H =0 x _A =0	x _H =+2c m x _A =-2cm	x _H =+6c m x _A =-6cm	x _H =+8c m x _A =-8cm	x_{H} =+9.8cm x_{A} =-9.8cm	x _H =+12c m x _A =-12cm	x _H =+14c m x _A =-14cm



角度付き+鏡リング反射像の検出のための 実験ラン反射像がうまく見えるようにHAPDと エアロゲルの位置を変えていた

HAPD, エアロゲル, 鏡が乗った台ごと
 ビームに垂直方向に移動: x_H
 台の上でさらにエアロゲルだけが
 入射角方向に移動: x_A

ビームテストのセットアップ



SC:トリガーシンチレーションカウンター

→シンチレーションカウンターを通過した電子ビームトラックのみが トリガーを発行しイベントとして記録される

MWPC: Multi Wire Propottional Chamber

→ガス検出器の一種で、電子ビームトラックの入射位置を検出する

各検出器の検出位置から飛跡を再構成している。

参考文献:片浦隆介さん修士論文(2016年)

HAPDのヒット点とリングイメージとの距離



ヒット点が予測リングの外側・内側のどちらにあるかの情報を得るために $\theta_e < \theta_h \rightarrow -r$ をつめる。 $\theta_h < \theta_e \rightarrow r$ をつめる。

πの予測リングとヒット点との距離

πリングとHAPDとの差[mm]



検出光子数の計算値

垂直入射時の1トラック当たりの検出光子数は10.71 (2015年岩田修一博士論文より)

角度付き入射の場合、トラックがシリカエアロゲルを通過する 距離が延びることより

$$10.71 \times \frac{1}{\cos 30^{\circ}} = 1.324$$
 と見積もった。

※実際は散乱の増加や吸収も増えるため正確な値ではない。 (Cf:減衰長40mm程度)

運動量ごとの識別能力



運動量GeV/c

低運動量領域ほど識別能力が高くなる